



Рис. 3. Зависимость дифференциальной термической энергии ионизации водородоподобных доноров E_{1d} или акцепторов E_{1a} от их концентрации N и степени компенсации K : линии – расчет по формуле (25) для температуры $T_1 \approx \frac{3T_j}{2}$ и степеней компенсации $K = 0,01$ (кривая 1), $K = 0,3$ (кривая 2), $K = 0,5$ (кривая 3); точки – экспериментальные данные для полупроводников n - и p -типа [41–55]

Fig. 3. Dependence of the differential thermal ionization energy of hydrogen-like donors E_{1d} or acceptors E_{1a} on their concentration N and compensation ratio K :

lines are the calculation by equation (25) for temperature $T_1 \approx \frac{3T_j}{2}$ and compensation ratios $K = 0.01$ (curve 1), $K = 0.3$ (curve 2), and $K = 0.5$ (curve 3); points are the experimental data for n -type and p -type semiconductors [41–55]